

(IRF510N CHINA)

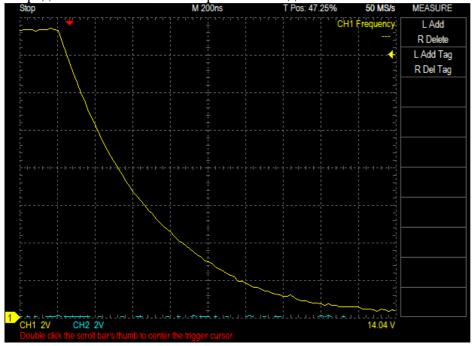
Замер на начальном, более-менее линейном, участке разряда емкости затвора, при этом тока стока нет, в обрыве, замер только разряда емкости исток-затвор.

Средний ток через резистор 1к от напряжения питания 15B (Выход UC2843): Icp=(15B-dU/2)/R

Транзистор IRF510 (прислали из Китая десяток): За время 1мкС затвор разряжается на 8В. Значит емкость: Сз=Icp*dt/dU=((15-4)/1000)*1/8=0,011/8=1.37н Φ А в даташите 180п Φ , что-то велика разница, правда это при Vgs = 0 V, Vds = 25V и частоте 1М Γ ц.

И еще несовпадение: сопротивление полностью открытого канала RDS(on)=0.066 Ом (при Vgs =6.5V), а в даташите RDS(on) =0.54 Ом при Vgs = 10 V. Значит прислали что-то более мощное, не IRF510. Для сравнения и эксперимента, нашел в старых запасах IRF510 (без N).

Разряд такой: за 300нС напряжение падает на 7В.



 $C_3 = 0.0115*0.37 = 0.00049 = 490 \pi \Phi$ Это уже ближе к описанию, хоть и метод замера другой.

Другие транзисторы:

```
C_{3}=0.011*2.2/8=0.00302=3нФ (у IRF540 в даташите 2600-3600 пФ при Vds = 25V f = 1 MHz) 

C_{3}=0.0115*1/7=0.0016=1.6нФ (у IRF630 в даташите 800 пФ при тех же усл. ) 

C_{3}=0.012*0.5/6=0.001=1нФ (у 2N60P в даташите 200-360 пФ при тех же усл. ) 

C_{3}=0.0115*2.2/7=0.0036=3.6нФ (у IRF3710 в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

C_{3}=0.013*3/4=0.00975=9.75нФ (у 2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

C_{3}=0.0125*1/5=0.0025=2.5нФ (у 2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

C_{3}=0.0125*3/5=7.5нФ (у 2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

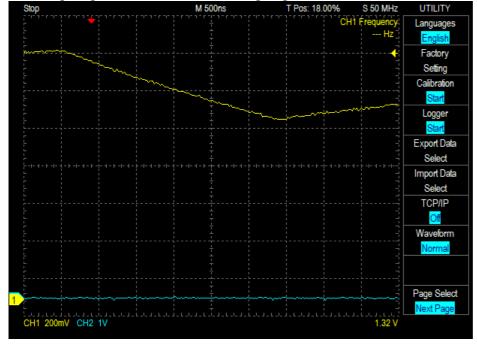
2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. ) 

2N60P в даташите 2930 пФ при тех же усл. )
```

Разброс большой, где-то совпадает, где-то нет. На высокой частоте прибором измерения не получались, показания пляшут в широких пределах.

И для проверки метода, конденсатор керамический: 0.01мк Φ = 0.013*3/3.8=10.2н Φ (совпадает)



конденсатор пленочн.: C(6n8) = 0.0125*3/5=7,5нФ (немного завышено)

